

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re U.S. Patent Application of

AOKI

Application Number: 10/082,338

Filed: February 26, 2002

For: SEMICONDUCTOR LASER

ATTORNEY DOCKET NO. ASAM.0042



Honorable Assistant Commissioner
for Patents
Washington, D.C. 20231

**REQUEST FOR PRIORITY
UNDER 35 U.S.C. § 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**

Sir:

In the matter of the above-captioned application for a United States patent, notice is hereby given that the Applicant claims the priority date of July 30, 2001, the filing date of the corresponding Japanese patent application 2001-228866.

The certified copy of corresponding Japanese patent application 2001-228866 is being submitted herewith. Acknowledgment of receipt of the certified copy is respectfully requested in due course.

Respectfully submitted,

Stanley P. Fisher
Registration Number 24,344

JUAN CARLOS A. MARQUEZ
Registration No. 34,072

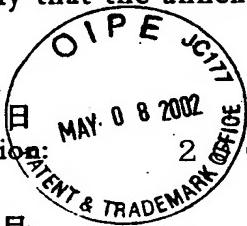
REED SMITH LLP
3110 Fairview Park Drive
Suite 1400
Falls Church, Virginia 22042
(703) 641-4200
May 8, 2002

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office

出願年月日 Date of Application: MAY 08 2002
2001年 7月30日



出願番号 Application Number: 特願2001-228866

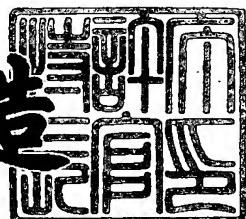
[ST.10/C]: [JP2001-228866]

出願人 Applicant(s): 株式会社日立製作所

2002年 3月 5日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3013377

【書類名】 特許願
【整理番号】 H01008531A
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H01S 03/101
【発明者】
【住所又は居所】 東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
【氏名】 青木 雅博
【特許出願人】
【識別番号】 000005108
【氏名又は名称】 株式会社 日立製作所
【代理人】
【識別番号】 100075096
【弁理士】
【氏名又は名称】 作田 康夫
【電話番号】 03-3212-1111
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 013088
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【フルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体レーザ

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体基板上にコア領域と、前記コア領域の基板側とは反対側に少なくとも設けられたクラッド領域とを有し、

前記コア領域の利得領域の長さが $18\mu m$ 以上 $200\mu m$ 以下であり、

前記コア領域、前記クラッド領域の少なくとも一方はストライプ形状であり、そのストライプ形状の前記コア領域、前記クラッド領域の少なくとも一方の光軸方向と垂直で、かつ、基板表面と平行な方向に前記ストライプ幅が変調されており

前記ストライプの両端近傍で前記ストライプ幅は横モードが单一となるカットオフ幅よりも狭く設定され、前記利得領域内に水平方向の横幅が横モードが单一となるカットオフ幅よりも広く設定されている部分を有することを特徴とする半導体レーザ。

【請求項2】

前記利得領域内に水平方向の横幅が横モードが单一となるカットオフ幅よりも広く設定されている部分は多横モード導波路部であることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ。

【請求項3】

多横モード導波路部の導波モードと横单一モード導波路部の導波モードと両導波路の接合部においてモード変換に伴う変換損失が最小になるように、多横モード導波路の導波路の横幅、導波路長を定めたことを特徴とする請求項1に記載の半導体レーザ。

【請求項4】

多横モード導波路の導波路の横幅W、導波路長L、レーザ導波路の有効屈折率n、動作波長λとを、

$$0.9nW^2/\lambda \leq L \leq 1.1nW^2/\lambda$$

を満たすように定めたことを特徴とする請求項1に記載の半導体レーザ。

【請求項5】

多横モード導波路の横幅Wが3~10 μ mであることを特徴とする請求項1に記載の半導体レーザ。

【請求項6】

前記クラッド領域および前記コア領域をエッチングすることにより形成した反射鏡を有することを特徴とする請求項1に記載の半導体レーザ。

【請求項7】

横单一モード導波路部に回折格子を形成しプラグ反射器を形成したことを特徴とする請求項1に記載の分布帰還型半導体レーザ。

【請求項8】

横单一モード導波路部に回折格子を形成しプラグ反射器を形成したことを特徴とする請求項1に記載の分布反射型半導体レーザ。

【請求項9】

前記プラグ反射器の反射波長を外部信号により変化させ発振波長を人為的に変化させることを特徴とする請求項7に記載の波長可変半導体レーザ。

【請求項10】

少なくとも光を外部に導く光ファイバと請求項1記載の半導体レーザとを一体化した光モジュール。

【請求項11】

半導体基板上にコア領域と、前記コア領域の基板側とは反対側に少なくとも設けられたクラッド層とを有し、

前記コア領域の利得領域の長さが5 μ m以上200 μ m以下であり、

前記コア領域、前記クラッド領域の少なくとも一方はストライプ形状であり、そのストライプ形状の前記コア領域、前記クラッド領域の少なくとも一方の光軸方向と垂直で、かつ、基板表面と平行な方向に前記ストライプ幅が変調されており

前記ストライプの一方の端部近傍で前記ストライプ幅は横モードが单一となるカットオフ幅よりも狭く設定され、前記利得領域内に水平方向の横幅が横モードが单一となるカットオフ幅よりも広く設定されている部分を有することを特徴とす

る半導体レーザ。

【請求項12】

前記利得領域内に水平方向の横幅が横モードが单一となるカットオフ幅よりも広く設定されている部分は多横モード導波路部であることを特徴とする請求項11記載の半導体レーザ。

【請求項13】

多横モード導波路部の導波モードと横单一モード導波路部の導波モードと両導波路の接合部においてモード変換に伴う変換損失が最小になるように、多横モード導波路の導波路の横幅、導波路長を定めたことを特徴とする請求項11に記載の半導体レーザ。

【請求項14】

多横モード導波路の導波路の横幅W、導波路長L、レーザ導波路の有効屈折率n、動作波長λとを、

$$0.9nW^2/\lambda \leq L \leq 1.1nW^2/\lambda$$

を満たすように定めたことを特徴とする請求項11に記載の半導体レーザ。

【請求項15】

多横モード導波路の導波路の横幅Wが3~10 μmであることを特徴とする請求項11に記載の半導体レーザ。

【請求項16】

前記クラッド層および前記コア層をエッチングすることにより形成した反射鏡を有することを特徴とする請求項11に記載の半導体レーザ。

【請求項17】

横单一モード導波路部に回折格子を形成しブラッグ反射器を形成したことを特徴とする請求項11に記載の分布帰還型半導体レーザ。

【請求項18】

横单一モード導波路部に回折格子を形成しブラッグ反射器を形成したことを特徴とする請求項11に記載の分布反射型半導体レーザ。

【請求項19】

前記ブラッグ反射器の反射波長を外部信号により変化させ発振波長を人為的に

変化させることを特徴とする請求項1.7に記載の波長可変半導体レーザ。

【請求項20】

少なくとも光を外部に導く光ファイバと請求項1.1記載の半導体レーザとを一体化した光モジュール。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は半導体レーザに係わり、特に共振器長が短く高速変調や広範囲波長可変動作に適した通信用半導体レーザとその光モジュールに関する。

【0002】

【従来の技術】

端面発光型半導体レーザの共振器長を $200\mu\text{m}$ 程度にまで低減し、低しきい値電流化や緩和振動周波数の増大を図ることが理論的・実験的に知られている。図1-1はレーザのしきい値電流、緩和振動周波数および直列抵抗のレーザ共振器長依存性を計算した一例である。レーザ活性層として格子歪系のInGaAsP多重量子井戸構造を仮定している。図より短共振器化は、低しきい値電流化および緩和振動周波数の増大に有効であることが判る。しかし、短共振器化に伴い直列抵抗が著しく上昇するため、レーザへの電流注入に伴うジユール熱の発生により光出力特性が大きく劣化する。例えば、共振器長 $100\mu\text{m}$ では直列抵抗は 20Ω に達するが、この値は通常用いられるレーザ共振器 $400\mu\text{m}$ の4倍もの値である。このような観点から、冒頭に述べたように半導体レーザの短共振器化による性能向上は $200\mu\text{m}$ 程度までしか実現できていないのが現状である。一方、分布反射型レーザにおいて、活性領域長を短縮することにより縦モードの安定化、波長可変幅の増大が図れることが知られている。これは、分布反射型レーザのモード飛び間隔 $\Delta\lambda$ と活性領域長 L_a との間に、 $\Delta\lambda = \lambda^2 / 2nL_a$ なる関係があるためである。ここで、 n はレーザ媒質の屈折率、 λ は発振波長である。この場合においても、 $\Delta\lambda$ を増大させるために共振器長や活性領域を短縮すると、レーザ利得の低下や、電気抵抗、熱抵抗の増大が生じるため実験での上記改善効果の報告はあるものの、実用には至っていないのが実情である。

尚、この種の半導体レーザとして第17回半導体レーザ国際会議テクニカルダイジェストペーパーThA4が挙げられる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、上記の問題を克服し低しきい値電流で高速動作可能な短共振器レーザや波長安定性に優れた波長可変レーザを実現する素子構造およびその作製方法を提供することを目的とする。特に従来構造では、実用化が困難であった $200\mu m$ 以下の共振器長を有する短共振器レーザを実現することを目的とする。また、これらの光素子を搭載した低成本で高性能動作可能な光モジュールを提供することを目的とする。

【0004】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明者らは、レーザ短共振器導波路の一部または全ての部位において導波路横幅を横多モードを許容する幅広に設定することにより、上述の短共振器レーザの特長を保ったまま、レーザ利得の向上、電気抵抗、熱抵抗の低減を図る素子構造を考案した。この際、多モード干渉効果による自己結像効果を用いることにより、レーザ共振器内でのモード変換損失を低減できる他、レーザの出射端における光強度分布が単峰な最低次モードとなり、光ファイバ等との接続に好適な構造となる。レーザ特性上本構造では多モード干渉導波路部の導波路寸法を正確に設定する必要があるため、寸法誤差の大きい従来のへき開法による共振器の形成は適さない。本発明では、リソグラフィー技術とドライエッティング技術の併用により多モード干渉導波路部を含むレーザ共振器を寸法精度高く作製する手法も合わせて考案した。

【0005】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図1～図9を用いて説明する。

実施の形態1

図1は本発明を用いて毎秒40ギガビット以上の高速直接変調を可能とする波長 $1.3\mu m$ 帯の半導体レーザを作製した例である。図1に示すように、n型(100)In

P半導体基板101上有機金属気相成長法により $1.0\mu m$ 厚のn型InPバッファ層102、 $0.5\mu m$ 厚のn型InAlAsバッファ層103、 $0.05\mu m$ 厚のn型InGaAlAs下側光ガイド層104、 $6.0nm$ 厚の1%圧縮歪InGaAlAs（組成波長 $1.37\mu m$ ）井戸層、 $10nm$ 厚のInGaAlAs（組成波長 $1.00\mu m$ ）障壁層からなる10周期の多重量子井戸層105、 $0.05\mu m$ 厚の上側光ガイド層106、 $0.1\mu m$ 厚のp型InAlAsクラッド層107、 $1.5\mu m$ 厚のp型InPクラッド層108、 $0.2\mu m$ 厚の高濃度p型InGaAsキャップ層を順次有機金属気相成長法により形成する。多重量子井戸活性層105の発光波長は約 $1.31\mu m$ である。

【0006】

次にストライプ形状の誘電体マスクを用いて公知の選択的ドライエッティング技術によりリッジ導波路を形成する。この際、図1に示すように幅 $1.6\mu m$ の直線形状の単一横モード導波路113に加え、導波路中央部で横幅が広がった多モード干渉導波路114を形成する。この多モード干渉導波路部の横幅 W_{mmi} と導波路長 L_{mmi} を適切な値に設計することにより、単一モード導波路と多モード干渉導波路間の高い光結合が実現される。ここでは、理論最適近似値($L_{mmi}=nW_{mmi}^2/\lambda$; nは導波路有効屈折率、 λ は動作波長)を考慮し、横幅を $6.0\mu m$ 、長さを $89.7\mu m$ とした。作製誤差の観点から $L_{mmi}=nW_{mmi}^2/\lambda$ を完全に満たすことは困難であるが、 L_{mmi} に±10%程度の誤差は通常許容される。また、多モード導波路の横幅 W_{mmi} は $3\mu m$ 程度が下限であるため、n=3.2程度であることを考慮すると、波長 $1.55\mu m$ の場合、 L_{mmi} の下限値は $18\mu m$ 程度となる。この後、公知のリッジ導波路レーザ構造にウェハ加工した。素子長 $100\mu m$ に切り出した後、素子の前面には反射率80%の高反射膜111、後端面には反射率97%の高反射膜112をそれぞれ形成した。図1に示すように、全て直線導波路からなる従来型の素子113を同一基板上に作製しリフレンスとしている。

【0007】

図2は類似の実施の形態を表す。図1の実施の形態と異なる点は、レーザ後方の反射端面を公知のドライエッティング技術を用いて作製した点である。この場合、レーザ共振器長を図1の実施の形態よりもさらに短い $50\mu m$ 以下にまで短縮でき、後述するように、緩和振動周波数の増大に有効である。

【0008】

図3は図2の実施の形態において、レーザ後方の反射ミラーを公知の半導体・空気からなる分布反射ミラー115に置き換え、さらにミラー後方に光出力モニタ16をモノリシック集積した形態である。

【0009】

図4は図2に示すレーザ素子の電流・光出力特性を85°C、CW条件にて調べた結果である。図示のように、従来型の直線導波路レーザでは、42mA程度の低電流レベルで光出力が熱飽和を起こした。この主原因は電気抵抗が高いことである。図4に同時プロットした電気抵抗値の電流依存性からわかるように、直線導波路素子では、 $50\ \mu\text{m}$ の短共振器化に伴い抵抗値が $40\ \Omega$ 以上と非常に高い値となっている。この出力飽和の影響で、所望の光出力が得られないばかりでなく、図5に示す緩和振動周波数の電流依存性から判るように26GHz程度で飽和してしまい、毎秒40ギガビット級の高速直接変調を実現することができない。これに対し、多モード干渉導波路を導入したレーザでは、電気抵抗が約半分の $20\ \Omega$ にまで低減されている。これは、多モード干渉導波路の導入による電流通電面積が増加した効果である。これにより、図4における飽和光出力は従来素子の約2倍にまで改善できた。また、緩和振動周波数も45GHzまで増大でき、毎秒40ギガビットの高速直接変調が実現可能となる。本発明のさらなる特長は、しきい値電流密度を低減できる点である。従来素子ではレーザ高速性を改善するために共振器長を短縮化すると、活性層体積の減少に伴いしきい値キャリア密度が著しく上昇する。このため、図6の利得-キャリア密度相関図に示すように利得飽和領域でレーザが動作する。これは微分利得を低減させるだけでなく、非線型ダンピングを増大させる。この結果、両効果は共にレーザの高速性を劣化させる。本発明によれば、特にしきい値電流密度の増大が問題となる短共振器レーザのしきい値電流密度を低減することができるため、緩和振動周波数の増大とダンピングの抑制を同時に達成できる。このため、簡易な手法でレーザ高速特性の改善を実現できる。

【0010】

以上、本発明の典型的な実施の形態をInGaAlAs材料を用いたリッジ導波路型レーザ構造を用いて説明した。本発明は、InGaAsP、GaInNAs、InGaAs、InGaAlP等

全ての半導体レーザ材料にて同様に適用可能である。また、リッジ導波路型レーザだけでなく、いわゆる埋め込みヘテロ構造、埋め込みリッジ構造を用いたレーザにも同様に適用可能であることを付記する。

実施の形態2

図7は本発明を用いて発振波長を電気信号により変化できる $1.55\text{ }\mu\text{m}$ 帯の分布反射型レーザを作製した例である。分布反射型レーザの連続波長可変特性は、レーザの縦モード跳びにより決定される。レーザ縦モード跳び間隔 $\Delta\lambda_{DBR}$ は活性領域長 L_a に依存し、

$$\Delta\lambda_{DBR} = \lambda^2 / 2nL_a \quad (1)$$

で与えられる。ここで、 λ は発振波長、 n はレーザ媒質の光学屈折率である。従って、連続波長可変幅を拡大させるためには少なくとも $\Delta\lambda_{DBR}$ を増大する必要がある。波長帯 λ が固定の場合、(1)式から明らかなように、 $\Delta\lambda_{DBR}$ の増大には、 L_a の短縮が唯一の有効手段である。実施の形態2では、実施の形態1と同様のアナロジーで、 L_a を短縮した際に顕在化する電気抵抗増大、出力の低下などレーザ特性の劣化を活性領域に多モード導波路を導入し改善できることを以下説明する。

【0011】

図7において、n型(100)InP半導体基板501上有機金属気相成長法により $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 厚のn型InGaAlAs屈折率制御層(組成波長 $1.40\text{ }\mu\text{m}$)503、 $0.02\text{ }\mu\text{m}$ 厚のInAlAsエッチング停止層、 $0.02\text{ }\mu\text{m}$ 厚のp型InPスペーサ層、 30nm 厚のInGaAsP(組成波長 $1.37\text{ }\mu\text{m}$)回折格子供給層504を順次有機金属気相成長法により形成する。次に、周期 241nm の均一回折格子を公知の手法により回折格子供給層504に刻印する。続いて、いずれも公知の選択エッチングと異種導波路の直接結合技術を用いて、歪InGaAlAs材料からなる5周期の多重量子井戸層502を後に分布反射型レーザの活性領域となる個所にのみ選択的に成長する。続いて $1.5\text{ }\mu\text{m}$ 厚のp型InPクラッド層505、 $0.2\text{ }\mu\text{m}$ 厚の高濃度p型InGaAsキャップ層を順次有機金属気相成長法により形成する。多重量子井戸活性層502の発光波長は約 $1.56\text{ }\mu\text{m}$ である。

【0012】

次に絶縁ストライプ形状のマスクを用いて公知の選択的ドライエッチング技術

によりリッジ導波路を形成する。この際、幅 $1.6\mu\text{m}$ の直線形状の単一横モード導波路を後に分布反射器、位相調整領域となる領域および活性領域の一部に形成する。さらに、導波路中央部で横幅が広がった多モード干渉導波路を活性領域の中央に形成する。この多モード干渉導波路部の横幅と導波路長を適切な値に設計することにより、単一モード導波路と多モード干渉導波路間の高い光結合が実現される。ここでは、横幅を $6.0\mu\text{m}$ 、 $74.6\mu\text{m}$ とした。分布反射器、位相調整領域、活性領域の長さはそれぞれ $250\mu\text{m}$ 、 $80\mu\text{m}$ 、 $100\mu\text{m}$ である。各領域の間には $25\mu\text{m}$ の分離領域を設けた。全素子長は $480\mu\text{m}$ である。成長終了後のウェハをこの後、公知のリッジ導波路レーザ構造にウェハ加工した、素子長 $480\mu\text{m}$ に切り出した後、素子の前端面には反射率0.1%の低反射膜510、後端面には反射率95%の高反射膜511をそれぞれ形成した。

【0013】

作製した分布反射型レーザは、 $1,550\text{nm}$ 帯に単一軸モード発振した。しきい値電流は約 10mA であった。レーザ電流 60mA でのチップ光出力は約 10mW と光通信用途に対し十分な出力を得た。レーザ電流を 60mA に保ったまま分布反射器に電流を通電し発振波長をチューニングした。波長可変特性を図8に示す。図8上側は活性領域と位相調整領域の長さの和が $410\mu\text{m}$ の従来型分布反射型レーザの波長チューニング特性である。 $410\mu\text{m}$ に対応した約 0.8nm の波長間隔で縦モード跳びが生じている。この縦モード跳びに伴い副モード抑圧比が大きく変動する。一方、本発明の素子では、縦モード跳び波長間隔は 1.6nm に拡大されると共に、縦モード跳びが生じる制御電流間隔が拡大している。これは、活性領域と位相調整領域の長さの和が $205\mu\text{m}$ に低減したためであり、モード跳びを生じない連続波長チューニング実現の観点から重要な改善である。一方、単一縦モード性の目安として 40dB を基準とすると、本発明の素子では従来素子に比べより広い制御電流範囲で、 40dB 以上の単一縦モード動作を実現していることがわかる。尚、縦モード跳びの間の波長に発振波長を設定することは、位相調整領域に印加する電流を調整することにより容易に実現可能である。

【0014】

このように、分布反射型レーザの活性領域に多モード干渉導波路を導入すること

とで、波長可変時のスペクトル單一性を保ちつつ、十分な光出力を得ることができる。

実施の形態3

図9は実施の形態3は実施の形態2のレーザにおいて、活性領域長を $33\mu m$ まで短縮し、連続波長可変域を拡大した構造である。この場合、位相調整領域を用いずに、数nm程度の連続波長可変が可能である。素子の基本構造・作製は、位相調整領域が無い点、光出力を増大する半導体光増幅器がレーザ出射端にモノリック集積化されたことを除き、実施の形態3の構造と同じである。レーザ設計上の主な相違点は、活性領域の短縮に伴うレーザ利得低下を補償する目的で回折格子の光結合係数を 200cm^{-1} と大きくしたことと、プラッグ波長近傍での安定な単一軸モード発振のため、活性層前後方の二領域の回折格子位相を反転させ、いわゆる $\lambda/4$ 位相シフト型とした点である。

【0015】

本発明のレーザにて、連続波長可変幅4nm、光増幅器出力10mWを容易に得ることができた。本実施の形態では、活性領域が短いため波長変化に伴う活性領域での光学位相変化はごく僅かである。この結果、縦モード飛びが生じにくくなつたことが本発明の重要な点であり、多モード干渉導波路の導入により、電気抵抗の急激な増大を抑制することができる点が発明の本質である。

実施の形態4

実施の形態3の構成に、電界吸収型光変調器736とパワーモニタ735をモノリック集積化した本発明の新たな実施の形態を図10に示す。この場合、記述の広範囲連続波長可変特性に加え、低チャープな高速変調が実現でき、特に高密度波長多重光伝送における好適な光源を提供するものである。

【0016】

以上実施の形態2～4を用いて、分布反射型レーザの活性領域を短縮化して、連続波長可変特性を改善する場合について、多モード干渉導波路を導入することの有用性に関し説明した。本効果は、サンプル回折格子構造、スーパーストラクチャー回折格子構造などを用いた類似の改良型分布反射型レーザにも同様に適用可能であることを付記する。

【0017】

【発明の効果】

本発明の実施例に係る半導体発光素子よれば、毎秒40ギガ以上の直接変調を実現できる。光部品の低価格化のみならず、この素子を適用した光通信システムの低価格化、大容量化を実現できる。また、安定な单一モード、高出力で動作する波長可変型分布反射型半導体レーザやこれを搭載した光モジュールを極めて容易な手法で実現できる。本発明の実施例を用いれば、素子性能、歩留まりが飛躍的に向上するだけでなく、この素子を適用した光通信システムの低価格化、大容量化、長距離化を容易に実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の作用を説明するための図である。

【図2】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図3】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図4】

本発明の効果を説明するための図である。

【図5】

本発明の効果を説明するための図である。

【図6】

本発明の原理を説明するための図である。

【図7】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図8】

本発明の効果を説明するための図である。

【図9】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図10】

本発明の実施例を説明するための図である。

【図11】

レーザ共振器長がレーザ特性に与える影響を説明するための図である。

【符号の説明】

101…n型(100)InP半導体基板、102…n型InPバッファ層、103…n型InAlAsバッファ層、104…n型InGaAlAs下側光ガイド層、105…多重量子井戸層、106…上側光ガイド層、107…p型InAlAsクラッド層、108…p型InPクラッド層、109…表面保護膜、110…上部電極、111…前方高反射膜、112…後方高反射膜、113…直線形状の単一横モード導波路、114…多モード干渉導波路、115…空気・半導体分布反射ミラー、116…光出力モニタ、117…下部電極、

501…n型(100)InP半導体基板、502…多重量子井戸層、503…n型InGaAlAs屈折率制御層、504…回折格子供給層、505…p型InPクラッド層、506…分布反射領域上部電極、507…位相調整領域上部電極、508…活性領域上部電極、509…表面保護膜、510…前方低反射膜、511…後方高反射膜、517…下部電極、531…分布反射領域、532…位相調整領域、533…多モード干渉導波路活性領域、

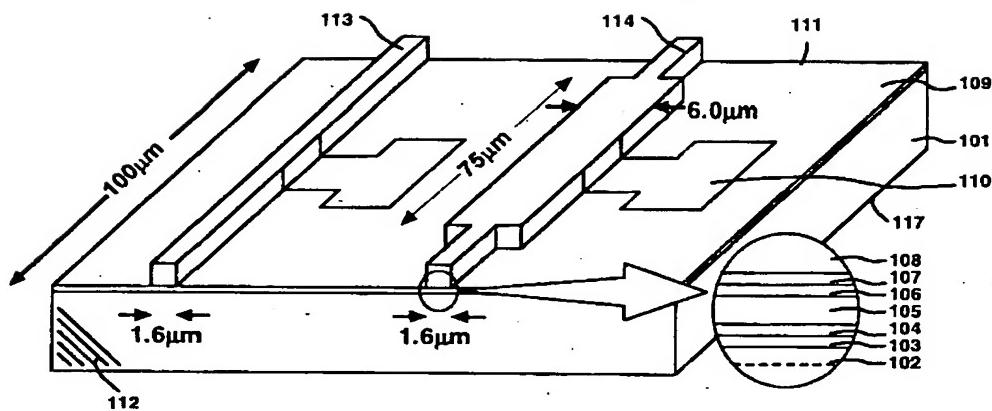
901…n型(100)InP半導体基板、902…後方分布反射器InGaAlAs屈折率制御層、903…前方分布反射器InGaAlAs屈折率制御層、904…回折格子供給層、905…レーザ活性領域多重量子井戸層、906…光增幅器活性領域多重量子井戸層、907…p型InPクラッド層、908…前方分布反射器上部電極、909…多モード干渉導波路レーザ活性領域上部電極、910…後方分布反射器上部電極、911…光增幅器活性領域上部電極、912…表面保護膜、913…前方低反射膜、914…後方低反射膜、917…下部電極、931…前方分布反射器、932…活性領域、933…後方分布反射器、934…光増幅器、
701…n型(100)InP半導体基板、702…分布反射器InGaAsP屈折率制御層、703…回折格子供給層、704…レーザ/光増幅器/光変調器活性領域多重量子井戸層、705…p型InPクラッド層、706…鉄ドープ半絶縁InP埋め込み層、707…窓領域、708…表面保護膜、709…低反射膜、717…下部電極、731…後方分布反射器、732…多モード干渉導波路活性領域、733…前方分布反射器、734…光増幅器、734…光出力モニタ、734…光変調器。

特2001-228866

【書類名】 図面

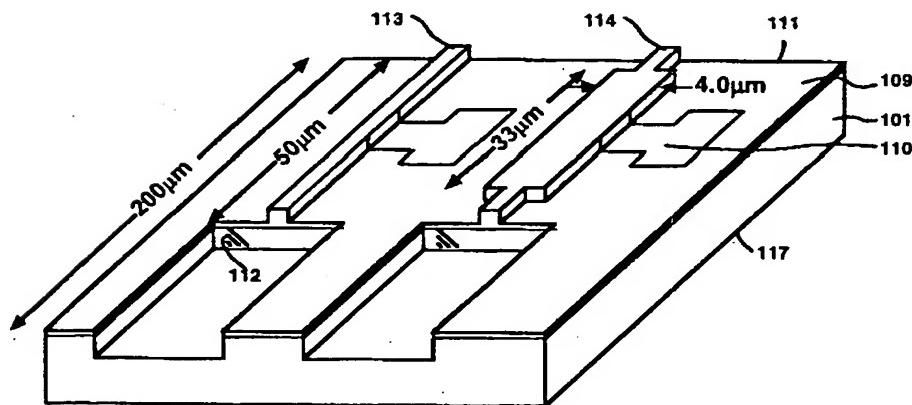
【図1】

図1



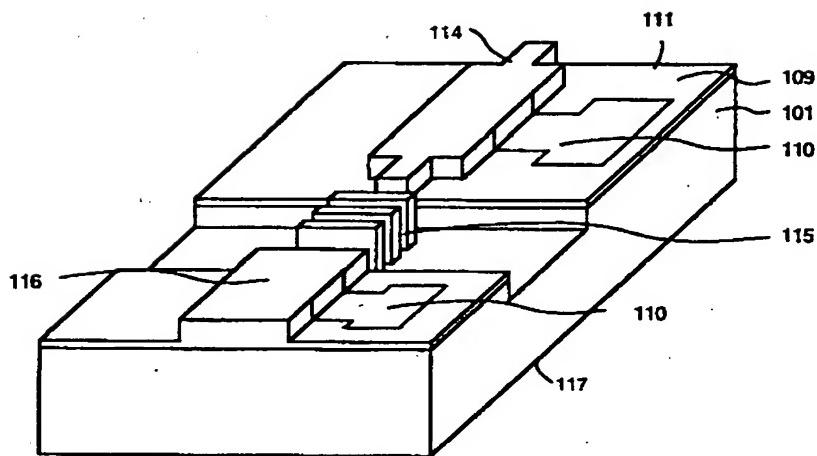
【図2】

図2



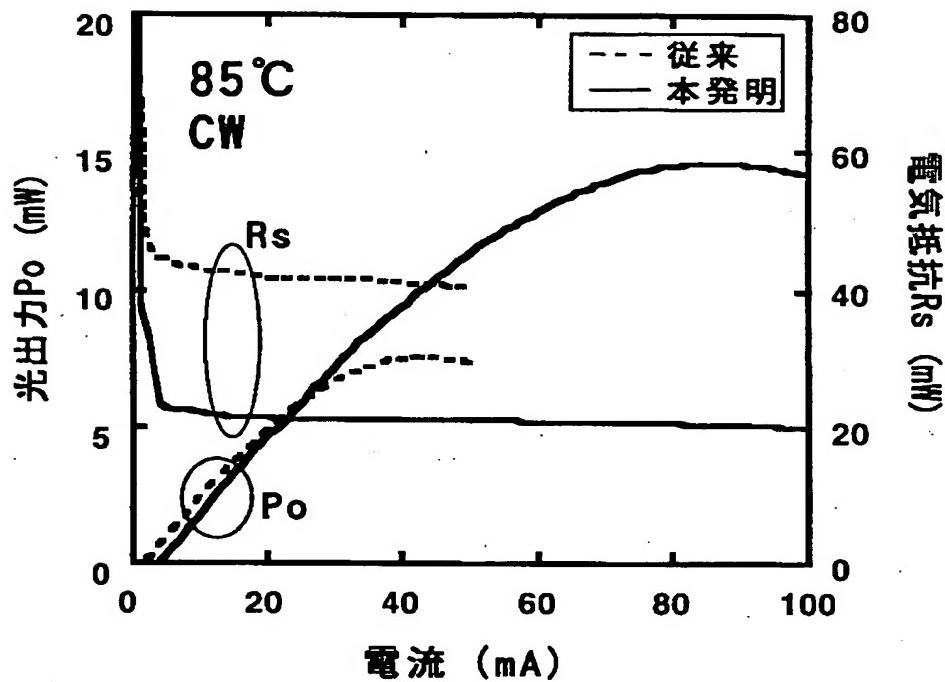
【図3】

図3



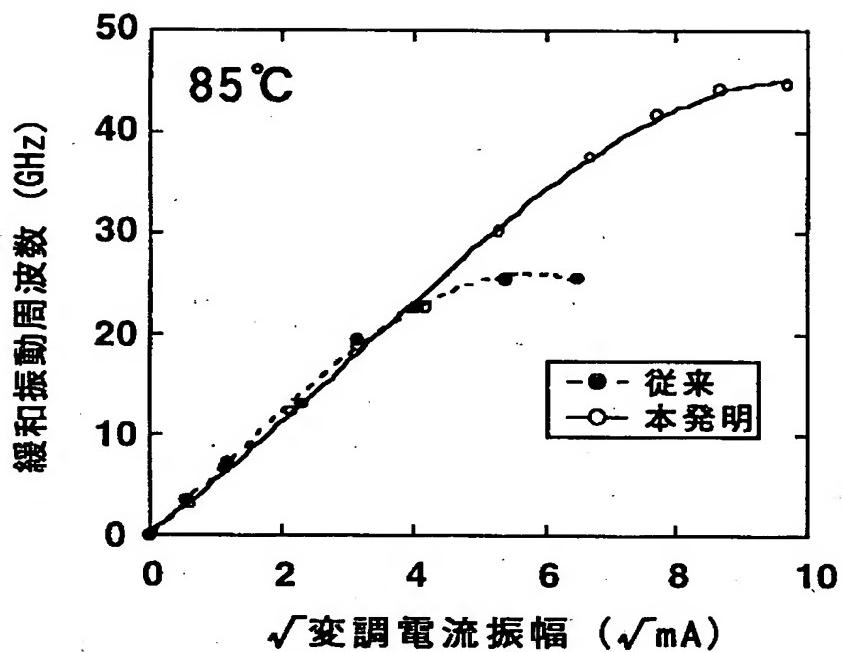
【図4】

図4



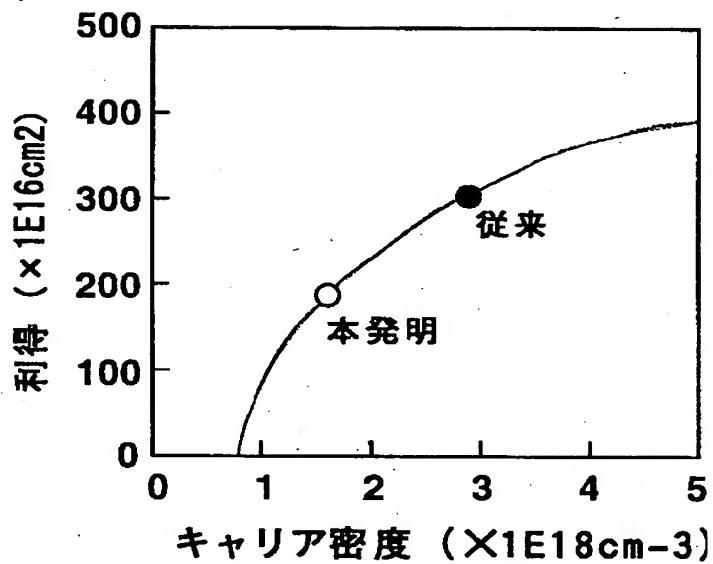
【図5】

図5



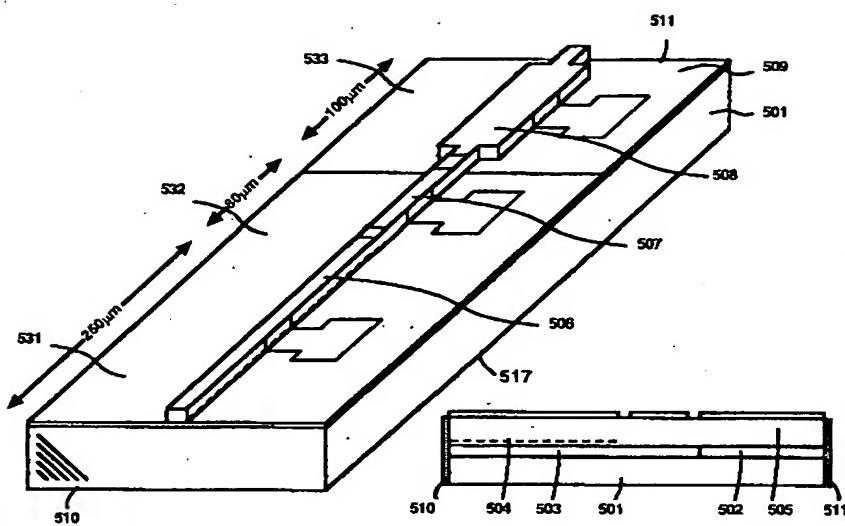
【図6】

図6



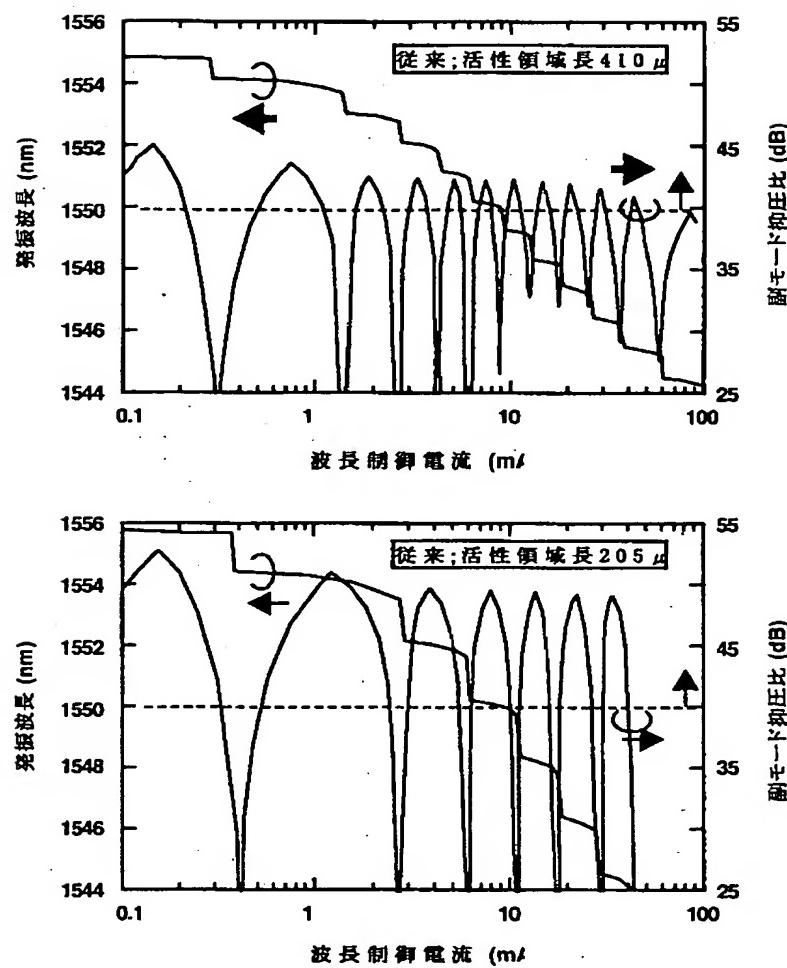
【図7】

図7



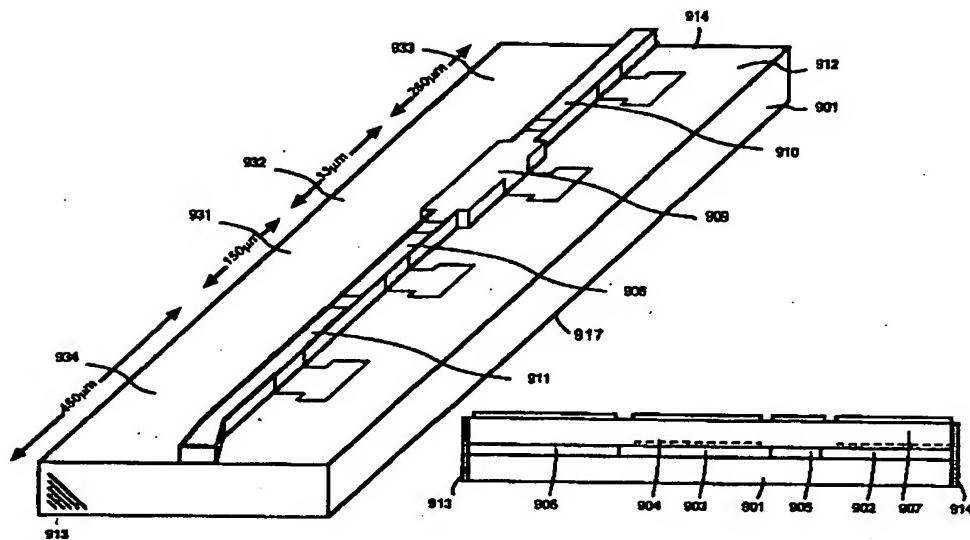
【図8】

図8



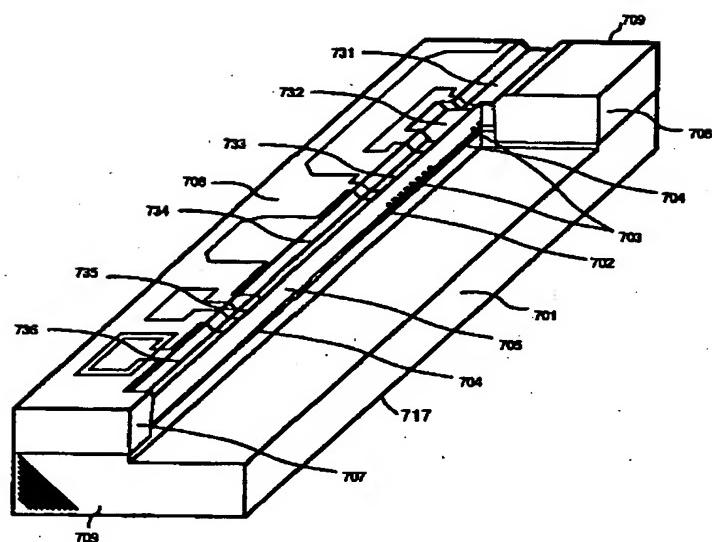
【図9】

図9



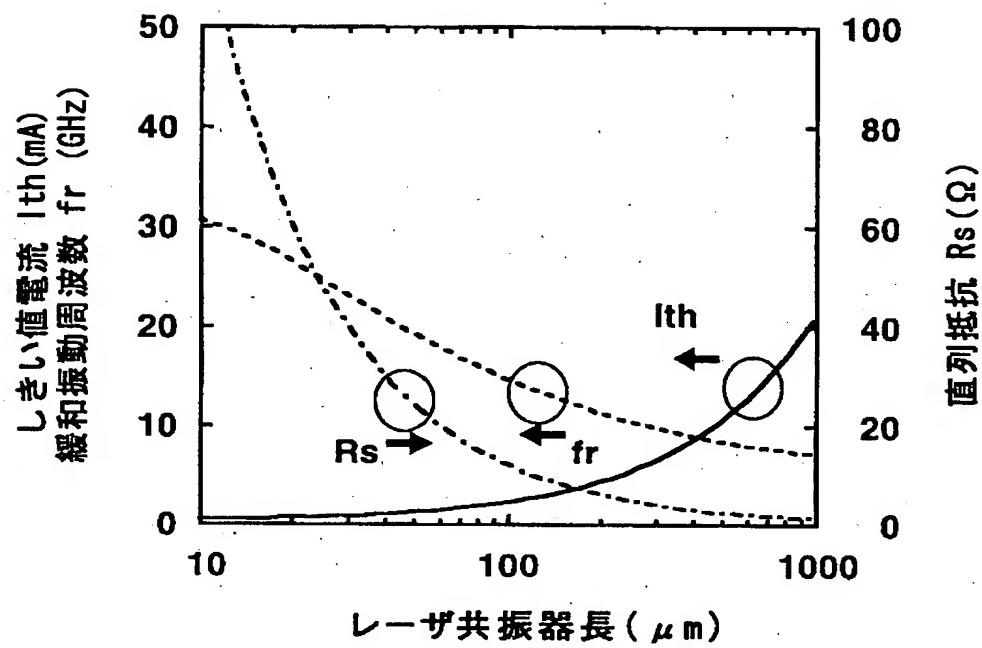
【図10】

図10



【図11】

図11



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 開示技術の課題は、上記の問題を克服し低しきい値電流で高速動作可能な短共振器レーザや波長安定性に優れた波長可変レーザを実現する素子構造およびその作製方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 上記目的を達成するために、レーザ短共振器導波路の一部または全ての部位において導波路横幅を横多モードを許容する幅広に設定する。これにより、上述の短共振器レーザの特長を保ったまま、レーザ利得の向上、電気抵抗、熱抵抗の低減を図る素子構造を考案した。この際、多モード干渉効果による自己結像効果を用いることにより、レーザ共振器内でのモード変換損失を低減できる他、レーザの出射端における光強度分布が単峰な最低次モードとなり、光ファイバ等との接続に好適な構造となる。また、リソグラフィー技術とドライエッティング技術の併用により多モード干渉導波路部を含むレーザ共振器を寸法精度高く作製する手法も合わせて考案した。

【選択図】 図9

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2001-228866
受付番号	50101111360
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成13年 7月31日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成13年 7月30日

次頁無

出願人履歴情報

識別番号 [000005108]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
氏 名 株式会社日立製作所